

【11】證書號數：I938404

【45】公告日：中華民國 115 (2026) 年 09 月 11 日

【51】Int. Cl. : C11D7/26 (2006.01) C11D7/32 (2006.01)
C11D7/34 (2006.01) C11D11/00 (2006.01)
H10P52/00 (2026.01)

發明

全 1 頁

【54】名稱：半導體基板用處理液

【21】申請案號：111139691

【22】申請日：中華民國 111 (2022) 年 10 月 19 日

【11】公開編號：202328425

【43】公開日期：中華民國 112 (2023) 年 07 月 16 日

【30】優先權：2021/10/29

日本

2021-177094

【72】發明人：上村哲也 (JP) KAMIMURA, TETSUYA；大內直子 (JP) OUCHI, NAOKO；
山田新平 (JP) YAMADA, SHIMPEI

【71】申請人：日商富士軟片股份有限公司 FUJIFILM CORPORATION
日本

【74】代理人：卓俊傑；鮑亞嵐

【56】參考文獻：

TW 201213540A

TW 202124700A

審查人員：鄭詠文

【57】申請專利範圍

1. 一種半導體基板用處理液，其包含兩性化合物、抗菌劑及胺基醇，
前述兩性化合物包含 pKa 小於 4.5 的酸基及 pKa 超過 4.5 的鹼基，
前述鹼基的數量多於前述酸基的數量，
前述抗菌劑包含至少一種以上選自包括陽離子系抗菌劑、羧酸系抗菌劑、酚系抗菌劑、
異噻唑啉系抗菌劑及醇系抗菌劑的群組中之抗菌劑，
前述兩性化合物的含量與前述抗菌劑的含量的質量比為 3.00 ~ 50.00，
前述胺基醇的含量與前記抗菌劑的含量的質量比為 10.00 ~ 150.00。
2. 如請求項 1 所述之半導體基板用處理液，其中
前述兩性化合物包含鹼性胺基酸。
3. 如請求項 1 或請求項 2 所述之半導體基板用處理液，其進一步包含有機酸。
4. 如請求項 1 或請求項 2 所述之半導體基板用處理液，其中
pH 為 4.0 ~ 8.0。
5. 如請求項 1 或請求項 2 所述之半導體基板用處理液，其用於清洗實施了化學機械研磨處理之具有鎢之半導體基板。